

41150918L7

证书号第 3344780 号



发明专利证书

发明名称：半导体器件结构和方法

发明人：梁启德;洪铭辉;刘泛鸿

专利号：ZL 2016 1 0209790.3

专利申请日：2016年04月06日

专利权人：台湾积体电路制造股份有限公司;梁启德

地址：中国台湾新竹

授权公告日：2019年04月23日

授权公告号：CN 106158858 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 3344780 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 06 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

台湾积体电路制造股份有限公司；梁启德

发明人：

梁启德；洪铭辉；刘泛鸿